

출력 일자: 2004/6/1

발송번호 : 9-5-2004-021266052

수신 : 서울 중구 태평로 2가 120 대경빌딩 9층(

발송일자 : 2004.05.31

법무법인 총정)

제출기일 : 2004.07.31

김석현 귀하

100-724

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 마쓰시다덴기산교 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980650737)

주소 일본국 오사카후 가도마시 오아자 가도마 1006반지

대리인 성명 김석현

주소 서울 중구 태평로 2가 120 대경빌딩 9층(법무법인 총정)

출원번호 10-2001-7016266

발명의 명칭 박막트랜지스터와 그 제조방법 및 그것을 사용한액정표시장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제 7항 및 제18항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 본원발명은 박막트랜지스터와 그 제조방법에 관한 것으로 특허청구범위 제7항은 다결정실리콘 반도체층을 가진 TFT에서 백라이트의 휘도를 2000(cd/㎡)이상으로 하는 경우, LDD의 길이가 1.0μm 이하인 것을 특징으로 하는데, 일본공개특허 평5-72555호(출원번호: 평3-235096호, 출원일: 91.9.13., 공개일: 93.3.26., 이하 제1인용참증이라 한다.)에서 다결정 실리콘 기판을 가진 TFT에서 LDD의 길이를 1.0μm이하로 하고 있어(상기 인용참증의 특허청구범위 제1항참조) 본항발명과 유사하며, 특히 양자는 액정표시장치라는 동일한 기술분야에 속하므로 당업자는 상기 제1인용참증으로부터 본항발명을 용이하게 실시할 수 있습니다.(제29조제2항)

2. 특허청구범위 제18항은 TFT 제조방법에 관한 것으로 박막트랜지스터의 제조공정에서 양극 산화공정에 의해 형성되는 측면 금속산화막의 두께를 제어하여 상기 불순물 도프 공정에서 형성되는 저농도 불순물 영역의 길이를 1.0μm이하로 하는 것을 특징으로 하는데, 일본공개특허 평5-114724호(출원번호: 평4-30220호, 출원일: 92.1.21., 공개일: 93.5.7., 이하 제2인용참증이라 한다.)에서 양측산화법에 의해 게이트 전극 측면에 형성된 산화물층을 마스크로 이용하여 불순물 영역을 형성/제어하고 있고, 제1인용참증에서 LDD의 길이를 1.0μm이하로 하고 있으며, 특히 상기 제1인용참증과 제2인용참증은 TFT 제조에 있어 LDD 관련 기술이란 점에서 동일한 기술분야에 속하므로 양자간 결합이 용이하며, 따라서 당업자는 상기 제1인용참증과 제2인용참증의 결합에 의해 본항발명을 용이하게 실시할 수 있습니다.(제29조제2항) 끝.

[첨부]

첨부 1 일본공개특허 평5-72555호

첨부 2 일본공개특허 평5-114724호 끝.

출력 일자: 2004/6/1

2004.05.31

특허청

전기전자심사국

영상기기심사담당관실

심사관 이종주



심사관 김민희



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-8192 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터